日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

07. 4. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-103438

[ST. 10/C]:

[JP2003-103438]

RECD 0 3 JUN 2004

PCT

WIPO

出 願 Applicant(s):

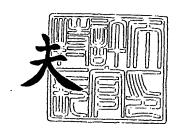
人

日立化成工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官

Commissioner, Japan Patent Office 2004年 5月20日



【書類名】 特許願

【整理番号】 HTK-668

【提出日】 平成15年 4月 7日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 23/00

C08G 59/00

CO8L 63/00

CO1B 25/00

【発明の名称】 封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】 水上 義裕

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】 遠藤 由則

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】 柏原 隆貴

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式会社 総合

研究所内

【氏名】 池澤 良一



【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】

萩原 伸介

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県結城市大字鹿窪1772-1 日立化成工業株式

会社 下館事業所内

【氏名】

吉井 正樹

【特許出願人】

【識別番号】

000004455

【氏名又は名称】 日立化成工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100083806

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 秀和

【選任した代理人】

【識別番号】

100068342

【弁理士】

【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】

100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001982

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0302311

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填剤、(D) カップリング剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料であって、

前記(C)無機充填剤の比表面積は3.0 \sim 6.0 $\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項2】 (D) カップリング剤の充填材被覆率が0.3~1.0である請求項1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項3】 200℃/1hr加熱後の加熱減量率が0.25質量%以下である請求項1又は2に記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項4】 (C)無機充填剤の平均粒径が15μm以下である請求項1~3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項5】 (D) カップリング剤は2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有するものである請求項1~4いずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項6】 2級アミノ基を有するシランカップリング剤は、下記一般式(I)で示される化合物を含有する請求項5記載の封止用エポキシ樹脂成形材料

【請求項7】 (A) エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂からなる群から選択される少なくとも1種を含有する請求項1~6のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項8】 (B) 硬化剤がビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂の少なくとも1種を含有する請求項1~7のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。



【請求項9】 (E) 硬化促進剤をさらに含有する請求項1~8のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料により封止された半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置に関する。

[0002]

さらに詳しくは、本発明はフリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止されたボイド等の成形不良や耐リフロー性、耐湿性等の信頼性が良好なフリップチップ実装型の半導体装置に関する。

[0003]

【従来の技術】

従来から、トランジスタ、IC等の電子部品装置の素子封止の分野では生産性、コスト等の面から樹脂封止が主流となり、エポキシ樹脂成形材料が広く用いられている。この理由としては、エポキシ樹脂が電気特性、耐湿性、耐熱性、機械特性、インサート品との接着性などの諸特性にバランスがとれているためである。また近年、電子部品のプリント配線板への高密度実装化が進んでいる。これに伴い、半導体装置は従来のピン挿入型のパッケージから、表面実装型のパッケージが主流になっている。表面実装型のIC、LSIなどは、実装密度を高くし実装高さを低くするために、薄型、小型のパッケージになっており、素子のパッケージに対する占有体積が大きくなり、パッケージの肉厚は非常に薄くなってきた。また素子の多機能化、大容量化によって、チップ面積の増大、多ピン化が進み、さらにはパッド(電極)数の増大によって、パッドピッチの縮小化とパッド寸法の縮小化、いわゆる狭パッドピッチ化も進んでいる。

[0004]

また、さらなる小型軽量化に対応すべく、パッケージの形態もQFP (Quad F



lat Package)、SOP (Small Outline Package)といったものから、より多ピン化に対応しやすく、かつより高密度実装が可能なCSP (Chip Size Package)やBGA (Ball Grid Array)へ移行しつつある。これらのパッケージは近年、高速化、多機能化を実現するために、フェースダウン型、積層(スタックド)型、フリップチップ型、ウェハーレベル型等、新しい構造のものが開発されている。

[0005]

フリップチップ実装は従来のワイヤーボンディングに代わる接続技術であり、半導体チップのパッド上にはんだバンプを付着させ、このバンプを利用して配線板上のランドと接続させるものである。はんだバンプを付着させたチップは配線板上で位置合わせを行った後、リフローによってはんだが溶融し、セルフアライメントプロセスを経て電気的、機械的な接続が形成される。このように実装されたデバイスには各種信頼性を向上させる目的で、はんだバンプで接合されたチップ/配線板の隙間にアンダーフィル材が注入される。このはんだバンプが配列された狭い隙間をボイド等の空隙を発生させずに完全に充填させるために、アンダーフィル材には高い充填性が要求される。

[0006]

この課題を解決するために、従来はビスフェノール型エポキシ樹脂を主成分とする溶剤又は無溶剤系の液状タイプの封止用エポキシ樹脂成形材料を使用し、毛細管現象を利用してチップ/配線板の隙間に浸透させ、硬化させる方式がとられてきた(例えば特許文献1~3、非特許文献1参照。)。

[0007]

【特許文献1】

特開2000-260820号公報

[0008]

【特許文献2】

特開2000-273287号公報

[0009]

【特許文献3】



特開2002-380483号公報

[0010]

【非特許文献1】

表面実装評議会監修 「フリップチップおよび関連チップスケール技術の実際」 (株)産業科学システムズ出版 1998年9月30日発行、p87

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

近年、コスト低減の観点から固形タイプの封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した真空方式の新規な成形技術がフリップチップのアンダーフィル用に開発されてきた。しかし従来の固形タイプの成形材料では充填性が低く、ボイド等の不良を発生させずに封止することが困難な状況にある。

[0012]

例えば、ファインピッチのはんだバンプ等を備える次世代フリップチップ型半導体装置の製造において、従来の固形タイプの封止用エポキシ樹脂を用いて封止する場合、直径0.1mm程度のやや大きめのボイドの発生に起因してアンダーフィル部の充填は満足できるものではなかった。

[0013]

さらにはフリップチップ実装型半導体装置におけるファイン化、すなわち、バンプ高さ、バンプピッチの低減や、また入出力数増大に伴うバンプ数、チップ面積の増大といった動向によって、今後はさらに高い充填性が要求される。

[0014]

そのため、フリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料が求められていた。さらに成形不良がなくしかも耐リフロー性及び耐湿性等の信頼性が良好な、ファインピッチのはんだバンプ等を備えるフリップチップ型半導体装置が求められていた。

[0015]

本発明の第1の側面によれば、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置の封止に適した封止用エポキシ 樹脂成形材料が提供される。



[0016]

本発明の第2の側面によれば、前記本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料 により封止された、ファインピッチなバンプを有し、入出力数 (バンプ数) の多いフリップチップ実装型半導体装置が提供される。

[0017]

【課題を解決するための手段】

発明者らは上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、特定の無機充填剤を必須成分とする、特定の半導体装置用の封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止された半導体装置により上記の目的を達成しうることを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0018]

すなわち、本発明は以下に関する。

[0019]

- 1. (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填剤、(D) カップリング剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料であって、
- 前記(C)無機充填剤の比表面積は3.0 \sim 6.0 m 2 /g である封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0020]

2. (D) カップリング剤の充填材被覆率が $0.3 \sim 1.0$ である前記1記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0021]

3. 200℃/1hr加熱後の加熱減量率が0.25質量%以下である前記1 又は2に記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0022]

4. (C)無機充填剤の平均粒径が15μm以下である前記1~3のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0023]

5. (D) カップリング剤は2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含有するものである前記1~4のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。



[0024]

6. 2級アミノ基を有するシランカップリング剤は、下記一般式 (I) で示される化合物を含有する前記5記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0025]

7. (A) エポキシ樹脂がビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂からなる群から選択される少なくとも1種を含有する前記1~6のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料

[0026]

8. (B) 硬化剤がビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボラック型フェノール樹脂の少なくとも1種を含有する前記1~7のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料。

[0027]

9. (E)硬化促進剤をさらに含有する前記1~8のいずれかに記載の封止用 エポキシ樹脂成形材料。

[0028]

10. 前記1~9のいずれかに記載の封止用エポキシ樹脂成形材料により封止された半導体装置。

[0029]

【発明の実施の形態】

(エポキシ樹脂)

本発明において用いられる(A)エポキシ樹脂は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン骨格を有するエポキシ樹脂をはじめとするフェノール、クレゾール、キシレノール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF



等のフェノール類及び/又はαーナフトール、βーナフトール、ジヒドロキシナ フタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオン アルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する 化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキ シ化したもの、ビスフェノールA、ビスフェノールF、ビスフェノールS、アル キル置換又は非置換のビフェノール等のジグリシジルエーテル、スチルベン型エ ポキシ樹脂、ハイドロキノン型エポキシ樹脂、フタル酸、ダイマー酸等の多塩基 酸とエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹 脂、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒ ドリンの反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタ ジエンとフェノール類の共縮合樹脂のエポキシ化物、ナフタレン環を有するエポ キシ樹脂、フェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラ ルキル型フェノール樹脂のエポキシ化物、トリメチロールプロパン型エポキシ樹 脂、テルペン変性エポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化して得 られる線状脂肪族エポキシ樹脂、脂環族エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹 脂などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよ 120

[0030]

なかでも、充填性及び耐リフロー性の観点からはビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型エポキシ樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂が好ましく、耐熱性及び低反り性の観点からはナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂が好ましく、これらのエポキシ樹脂の少なくとも1種を含有していることが好ましい。

[0031]

ビフェニル型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(IV)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、ビスフェノールF型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(V)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、スチルベン型エポキシ樹脂



としてはたとえば下記一般式 (VI) で示されるエポキシ樹脂等が挙げられ、硫黄原子含有エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式 (VII) で示されるエポキシ 樹脂等が挙げられる。

[0032]

【化1】

(ここで、 $R^{1}\sim R^{8}$ は水素原子及び炭素数 $1\sim 10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。 n は $0\sim 3$ の整数を示す。)

【化2】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{-CH-CH}_2 + \\ \text{O} \\ \text{R}^3 \\ \text{R}^4 \\ \text{R}^7 \\ \text{R}^8 \\ \text{OH} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{R}^5 \\ \text{O} \\ \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \\ \text{OH} \\ \text$$

(ここで、R¹~R⁸は水素原子、炭素数1~10のアルキル基、炭素数1~10のアルコキシル基、炭素数6~10のアリール基、及び炭素数6~10のアラルキル基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは0~3の整数を示す。)

【化3】

(ここで、 $R^{1}\sim R^{8}$ は水素原子及び炭素数 $1\sim 5$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。 n は $0\sim 1$ 0 の整数を示す。)



【化4】

(ここで、 $R^{1}\sim R^{8}$ は水素原子、置換又は非置換の炭素数 $1\sim 10$ のアルキル基及び置換又は非置換の炭素数 $1\sim 10$ のアルコキシ基から選ばれ、全てが同一でも異なっていてもよい。nは $0\sim 3$ の整数を示す。)

上記一般式(IV)で示されるビフェニル型エポキシ樹脂としては、たとえば、4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)ビフェニル又は4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5' -テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂、エピクロルヒドリンと4, 4' -ビフェノール又は4, 4' -(3, 3', 5, 5' -テトラメチル)ビフェノールとを反応させて得られるエポキシ樹脂等が挙げられる。なかでも4, 4' -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ)-3, 3', 5, 5' -テトラメチルビフェニルを主成分とするエポキシ樹脂が好ましい。

[0033]

上記一般式 (V) で示されるビスフェノールF型エポキシ樹脂はとしては、例えば、 R^1 、 R^3 、 R^6 及び R^8 がメチル基で、 R^2 、 R^4 、 R^5 及び R^7 が水素原子であり、n=0を主成分とするY S L V-8 O X Y (新日鉄化学株式会社製商品名)が市販品として入手可能である。

[0034]



'ージメチルスチルベン等が挙げられ、なかでも3-tープチルー4, 4'ージヒドロキシー3', 5, 5'ートリメチルスチルベン、及び4, 4'ージヒドロキシー3, 3', 5, 5'ーテトラメチルスチルベンが好ましい。これらのスチルベン型フェノール類は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

[0035]

上記一般式(VII)で示される硫黄原子含有エポキシ樹脂のなかでも、 R^2 、 R^3 、 R^6 及び R^7 が水素原子で、 R^1 、 R^4 、 R^5 及び R^8 がアルキル基であるエポキシ樹脂が好ましく、 R^2 、 R^3 、 R^6 及び R^7 が水素原子で、 R^1 及び R^8 が t - ブチル基で、 R^4 及び R^5 がメチル基であるエポキシ樹脂がより好ましい。このような化合物としては、YSLV-120TE (新日鐵化学社製)等が市販品として入手可能である。

[0036]

これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

[0037]

ノボラック型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式 (VIII) で示される エポキシ樹脂等が挙げられる。

[0038]

【化5】

$$\begin{array}{c|c} CH_2CH^-CH_2^-O & CH_2^-CH^-CH_2^-O & CH_2CH^-CH_2^-O \\ \hline \\ O & CH_2 &$$

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $0\sim10$ の整数を示す。)

上記一般式(VIII)で示されるノボラック型エポキシ樹脂は、ノボラック型フェノール樹脂にエピクロルヒドリンを反応させることによって容易に得られる。



なかでも、一般式(VIII)中のRとしては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数1~10のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~10のアルコキシル基が好ましく、水素原子又はメチル基がより好ましい。nは0~3の整数が好ましい。上記一般式(VIII)で示されるノボラック型エポキシ樹脂のなかでも、オルトクレゾールノボラック型エポキシ樹脂が好ましい。

[0039]

ノボラック型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30 重量%以上がより好ましい。

[0040]

ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂としては、たとえば下記一般式 (IX) で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

[0041]

【化6】

(ここで、 R^1 及び R^2 は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは $0\sim10$ の整数を示し、mは $0\sim6$ の整数を示す。)

上記式 (IX) 中のR¹としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、tーブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでもメチル基、エチル基等のアルキル基及び水素原子が好ましく、メチル基及び水素原子がより好ましい。R²としては、たとえば、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプ



ロピル基、tーブチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、プテニル基等のアルケニル基、ハロゲン化アルキル基、アミノ基置換アルキル基、メルカプト基置換アルキル基などの炭素数1~5の置換又は非置換の一価の炭化水素基が挙げられ、なかでも水素原子が好ましい。

[0042]

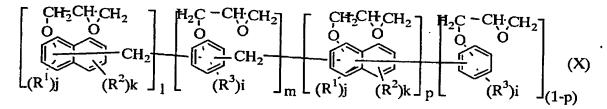
ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましい。

[0043]

ナフタレン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(X)で示されるエポーキシ樹脂等が挙げられ、トリフェニルメタン型エポキシ樹脂としてはたとえば下記一般式(XI)で示されるエポキシ樹脂等が挙げられる。

[0044]

【化7】



(ここで、 $R^{1}\sim R^{3}$ は水素原子及び置換又は非置換の炭素数 $1\sim 1$ 2 の一価の炭化水素基から選ばれ、それぞれ全てが同一でも異なっていてもよい。 p は 1 又は 0 で、 1 、m はそれぞれ $0\sim 1$ 1 の整数であって、(1+m)が $1\sim 1$ 1 の整数でかつ(1+p)が $1\sim 1$ 2 の整数となるよう選ばれる。 i は $0\sim 3$ の整数、 j は $0\sim 2$ の整数、 k は $0\sim 4$ の整数を示す。)

上記一般式(X)で示されるナフタレン型エポキシ樹脂としては、1個の構成単位及びm個の構成単位をランダムに含むランダム共重合体、交互に含む交互共重合体、規則的に含む共重合体、ブロック状に含むブロック共重合体が挙げられ、これらのいずれか1種を単独で用いても、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

[0045]



【化8】

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $1\sim10$ の整数を示す。)

これらのエポキシ樹脂はいずれか1種を単独で用いても両者を組合わせて用いてもよいが、その配合量は、その性能を発揮するためにエポキシ樹脂全量に対して合わせて20重量%以上とすることが好ましく、30重量%以上がより好ましく、50重量%以上とすることがさらに好ましい。

[0046]

上記のビフェニル型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、硫黄原子含有エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量はエポキシ樹脂全量に対して合わせて50重量%以上とすることが好ましく、60重量%以上がより好ましく、80重量%以上がさらに好ましい。

[0047]

本発明において用いられる(A) エポキシ樹脂の150℃における溶融粘度は、充填性の観点から2ポイズ以下が好ましく、1ポイズ以下がより好ましく、0.5ポイズ以下がさらに好ましい。ここで、溶融粘度とはICIコーンプレート粘度計で測定した粘度を示す。

[0048]

(加熱減量率)

エポキシ樹脂組成物の加熱減量率は0.25質量%以下が必須であるが、好ましくは0.22質量%以下、より好ましくは0.20質量%以下である。加熱減量率が0.25質量%を超えると、成形時に発生する揮発分による気泡が増加して



、薄肉部のボイドが発生しやすくなる。

[0049]

(加熱減量率の定義)

重量Aの耐熱性容器に樹脂組成物を加えた重量 W_0 を測定する。これを200 \mathbb{C} 雰囲気下にて1時間放置した後、容器と樹脂組成物の合計重量Wを測定する。このとき加熱減量率Yは次式により求まる。

 $Y = 1 \ 0 \ 0 \times (W_0 - W) / (W_0 - A)$

(加熱減量率の制御方法)

加熱減量率測定時に発生する揮発成分は、主に水分とアルコール類である。従って、成形前エポキシ樹脂組成物の含水率低減、カップリング剤の最小必要量への最適化、揮発成分を生成し難いカップリング剤の使用等が有効である。

[0051]

(硬化剤)

本発明において用いられる(B)硬化剤は、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、たとえば、フェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールA、ビスフェノールF、フェニルフェノール、アミノフェノール等のフェノール類及び/又はαーナフトール、βーナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデヒド、ベンズアルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られるノボラック型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とジメトキシパラキシレン又はビス(メトキシメチル)ピフェニルから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等のアラルキル型フェノール樹脂、フェノール類及び/又はナフトール類とシクロペンタジエンから共重合により合成される、ジクロペンタジエン型フェノールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等のジクロペンタジエン型フェノール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。

[0052]

なかでも、難燃性の観点からはビフェニル型フェノール樹脂が好ましく、耐リフロー性及び硬化性の観点からはアラルキル型フェノール樹脂が好ましく、低吸湿性の観点からはジシクロペンタジエン型フェノール樹脂が好ましく、耐熱性、低膨張率及び低そり性の観点からはトリフェニルメタン型フェノール樹脂が好ましく、硬化性の観点からはノボラック型フェノール樹脂が好ましく、これらのフェノール樹脂の少なくとも1種を含有していることが好ましい。

[0053]

ビフェニル型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XII)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

[0054]

【化9】

上記式(XII)中の R^{1} ~ R^{9} は全てが同一でも異なっていてもよく、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソプロピル基、イソブチル基等の炭素数 $1\sim10$ のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数 $1\sim10$ のアルコキシル基、フェニル基、トリル基、キシリル基等の炭素数 $6\sim10$ のアリール基、及び、ベンジル基、フェネチル基等の炭素数 $6\sim10$ のアラルキル基から選ばれ、なかでも水素原子とメチル基が好ましい。 nは $0\sim10$ の整数を示す。

[0055]

上記一般式(XII)で示されるビフェニル型フェノール樹脂としては、たとえば $R^{1}\sim R^{9}$ が全て水素原子である化合物等が挙げられ、なかでも溶融粘度の観点から、nが 1 以上の縮合体を 5 0 重量%以上含む縮合体の混合物が好ましい。このような化合物としては、MEH-7851 (明和化成株式会社製商品名)が市販品として入手可能である。

[0056]



ビフェニル型フェノール樹脂を使用する場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましく、60重量%以上がさらに好ましい。

[0057]

アラルキル型フェノール樹脂としては、たとえばフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル樹脂等が挙げられ、下記一般式(XIII)で示されるフェノール・アラルキル樹脂が好ましく、一般式(XIII)中のRが水素原子で、nの平均値が0~8であるフェノール・アラルキル樹脂がより好ましい。具体例としては、pーキシリレン型フェノール・アラルキル樹脂、mーキシリレン型フェノール・アラルキル樹脂等が挙げられる。これらのアラルキル型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

[0058]

【化10】

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $0\sim10$ の整数を示す。)

ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XIV)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

[0059]

【化11】

$$\bigcap_{R^1}^{OH} \bigcap_{(R^2)_m}^{OH} \bigcap_{R^1}^{OH} \bigcap_{(R^2)_m}^{OH} (XIV)$$

(ここで、 R^1 及び R^2 は水素原子及び炭素数 $1\sim 10$ の置換又は非置換の一価の



炭化水素基からそれぞれ独立して選ばれ、nは $0\sim1$ 0の整数を示し、mは $0\sim6$ の整数を示す。)

ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

[0060]

トリフェニルメタン型フェノール樹脂としては、たとえば下記一般式(XV)で示されるフェノール樹脂等が挙げられる。

[0061]

【化12】

$$\begin{array}{c}
OH \\
OH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
CH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
OH \\
R
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(XV) \\
R
\end{array}$$

(ここで、R は水素原子及び炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換の一価の炭化水素基から選ばれ、n は $1\sim10$ の整数を示す。)

トリフェニルメタン型フェノール樹脂を用いる場合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

[0062]

ノボラック型フェノール樹脂としては、たとえばフェノールノボラック樹脂、 クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂等が挙げられ、なかでも フェノールノボラック樹脂が好ましい。ノボラック型フェノール樹脂を用いる場 合、その配合量は、その性能を発揮するために硬化剤全量に対して30重量%以 上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい。

[0063]

上記のビフェニル型フェノール樹脂、アラルキル型フェノール樹脂、ジシクロペンタジエン型フェノール樹脂、トリフェニルメタン型フェノール樹脂及びノボ



ラック型フェノール樹脂は、いずれか1種を単独で用いても2種以上を組合わせて用いてもよいが、その配合量は硬化剤全量に対して合わせて60重量%以上とすることが好ましく、80重量%以上がより好ましい。

[0064]

本発明において用いられる(B)硬化剤の150℃における溶融粘度は、充填性の観点から2ポイズ以下が好ましく、1ポイズ以下がより好ましい。ここで、溶融粘度とはICI粘度を示す。

[0065]

(A) エポキシ樹脂と(B) 硬化剤との当量比、すなわち、エポキシ樹脂中のエポキシ基数に対する硬化剤中の水酸基数の比(硬化剤中の水酸基数/エポキシ樹脂中のエポキシ基数)は、特に制限はないが、それぞれの未反応分を少なく抑えるために $0.5\sim2$ の範囲に設定されることが好ましく、 $0.6\sim1.3$ がより好ましい。成形性及び耐リフロー性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料を得るためには $0.8\sim1.2$ の範囲に設定されることがさらに好ましい。

[0066]

(無機充填剤)

本発明において用いられる(C)無機充填剤は、吸湿性、線膨張係数低減、熱 伝導性向上及び強度向上のために封止用エポキシ樹脂成形材料に配合されるもの であり、たとえば、溶融シリカ、結晶シリカ、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、チタン酸カリウム、炭化珪素、窒化圧水ミ、窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア、ジルコン、フォステライト、ステアタイト、スピネル、ムライト、チタニア等の粉体又はこれらを球形化したビーズ、ガラス繊維などが挙げられる。さらに、難燃効果のある無機充填剤としては水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、硼酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛などが挙げられる。

[0067]

これらの無機充填剤は単独で用いても2種以上を組み合わせて用いてもよい。 なかでも、充填性、線膨張係数の低減の観点からは溶融シリカが、高熱伝導性の 観点からはアルミナが好ましく、無機充填剤の形状は充填性及び金型摩耗性の点



から球形が好ましい。

[0068]

本発明において用いられる(C)無機充填剤はその平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m²/g であることがファインピッチなバンプを有するフリップチップ実装のアンダーフィル用途の充填性を満足させる観点から必要である。平均粒径はより好ましくは 10μ m以下、さらに好ましくは 8μ m以下である。 15μ mを超えた場合はバンプで接合されたチップ/配線板の隙間にエポキシ樹脂成形材料が注入され難くなり、充填性が低下する。また比表面積はより好ましくは $3.5\sim5.5$ m²/g、さらに好ましくは $4.0\sim5.0$ m²/g である。3.0 m²/g 未満及び6.0 m²/g を超えた場合はバンプで接合されたチップ/配線板の隙間中にボイドが発生し易くなり、充填性が低下する。

[0069]

また充填性の観点からは(C)無機充填剤の粗粒子分を篩にてカットしてもよい。この時 5.3μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることが好ましく、 3.0μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがより好ましく、 2.0μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがさらに好ましい。

[0070]

(C)無機充填剤の配合量は、充填性、信頼性の観点から封止用エポキシ樹脂成形材料に対して60~95重量%が好ましい。70~90重量%がより好ましく、75~85重量%がさらに好ましい。60重量%未満であると耐リフロー性が低下する傾向にあり、95重量%を超えると充填性が低下する傾向にある。

[0071]

(2級アミノ基を有するシランカップリング剤)

本発明において用いられる(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤は分子内に 2級アミノ基を有するシラン化合物であれば特に制限はないが、たとえば、 γ -アニリノプロピルトリメトキシシラン、 γ -アニリノプロピルトリエトキシシラン、 γ -アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アニリノプロピルメチルジエトキシシラン、 γ -アニリノプロピルエチルジエトキシシラン、 γ -アニリノプロピルエチルジオト





キシシラン、γーアニリノメチルトリエトキシシラン、γーアニリノメチルメチ ルジメトキシシラン、γーアニリノメチルメチルジエトキシシラン、γーアニリ ノメチルエチルジエトキシシラン、γ-アニリノメチルエチルジメトキシシラン 、N-(p-メトキシフェニル)-γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N $-(p-メトキシフェニル) - \gamma - アミノプロピルトリエトキシシラン、<math>N-($ p-メトキシフェニル) $-\gamma$ -アミノプロピルメチルジメトキシシラン、N- (p-メトキシフェニル) $-\gamma$ - γ p-メトキシフェニル) - γ p-メトキシフェニル) - γ -アミノプロピルエチルジメトキシシラン、 γ - (N-メチル) アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma-$ (N-エチル) アミノプ ロピルトリメトキシシラン、 γ - (N-ブチル) アミノプロピルトリメトキシシ ラン、 γ - (N-ベンジル) アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ - (N-メチル) アミノプロピルトリエトキシシラン、γ - (N-エチル) アミノプロピル トリエトキシシラン、γー (Nープチル) アミノプロピルトリエトキシシラン、 γ - $(N-ベンジル) アミノプロピルトリエトキシシラン、<math>\gamma$ - (N-メチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ - (N-エチル) アミノプロピルメ チルジメトキシシラン、 $\gamma-$ (N-プチル)アミノプロピルメチルジメトキシシ ラン、 γ - $(N-ベンジル) アミノプロピルメチルジメトキシシラン、<math>N-\beta$ -(アミノエチル) $-\gamma$ - γ - エチル) アミノプロピルトリメトキシシラン、 $N-\beta-$ (N-ビニルベンジルア ミノエチル) - γ - アミノプロピルトリメトキシシラン等が挙げられる。

[0072]

なかでも充填性の観点からは、下記一般式(I)で示されるアミノシランカップリング剤が好ましい。

[0073]





【化13】

$$\begin{array}{c|c} R^{1} & & \\ \hline & NH + \left(CH_{2}\right)_{n} & Sj + \left(OR^{3}\right)_{m} & (I) \\ \hline & R^{2}_{3-m} & \end{array}$$

(ここで、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及び炭素数 $1\sim 2$ のアルコキシ基から選ばれ、 R^2 は炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基及びフェニル基から選ばれ、 R^3 はメチル基又はエチル基を示し、nは $1\sim 6$ の整数を示し、mは $1\sim 3$ の整数を示す。)

上記一般式 (I) で示されるアミノシランカップリング剤としては、たとえば γ ーアニリノプロピルトリメトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルトリエトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルトリエトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルメチルジエトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルエチルジストキシシラン、 γ ーアニリノプロピルエチルジメトキシシラン、 γ ーアニリノプロピルエチルジメトキシシラン、 γ ーアニリノメチルトリエトキシシラン、 γ ーアニリノメチルメチルジストキシシラン、 γ ーアニリノメチルメチルジエトキシシラン、 γ ーアニリノメチルスチルジストキシシラン、 γ ーアニリノメチルエチルジストキシシラン、 γ ーアニリノメチルエチルジストキシシラン、 γ ーアニリノメチルエチルジストキシシラン、 γ ークーメトキシフェニル) ー γ ーアミノプロピルトリエトキシシラン、 γ ークーメトキシフェニル) ー γ ーアミノプロピルメチルジストキシシラン、 γ トキシフェニル) ー γ ーアミノプロピルエチルジエトキシシラン、 γ トキシフェニル) ー γ ーアミノプロピルエチルジストキシシラン等が挙げられる。特に好ましくは、 γ ーアニリノプロピルエチルジメトキシシランである。

[0074]

(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤の配合量は、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.037~4.75重量%であることが好ましく、0.088~2.3重量%であることがさらに好ましい。0.037重量%未満では流動性が低下し、ボイド等充填性に関する成形不良が発生しやすくなる傾向や



、配線板との接着性が低下する傾向がある。4.75重量%を超えると揮発分が多くなり、ボイド等充填性に関する成形不良が発生しやすくなる傾向があるとともにパッケージの成形性が低下する傾向がある。

[0075]

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、樹脂成分と充項剤との接着性を高めるために、カップリング剤を配合することが好ましい。カップリング剤としては、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤が好ましいが、本発明の効果を達成できる範囲内で必要に応じてその他のカップリング剤を併用することができる。

[0076]

(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤と併用できるその他のカッ プリング剤としては、封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもの で特に制限はないが、たとえば、1級アミノ基及び/又は3級アミノ基を有する シラン化合物、エポキシシラン、メルカプトシラン、アルキルシラン、フェニル シラン、ウレイドシラン、ビニルシラン等の各種シラン系化合物、チタン系化合 物、アルミニウムキレート類、アルミニウム/ジルコニウム系化合物等が挙げら れる。これらを例示すると、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリエトキシシラ ン、ビニルトリス(β ーメトキシエトキシ)シラン、 γ ーメタクリロキシプロピ ν トリメトキシシラン、 β - (3, 4 -エポキシシクロヘキシル) エチルトリメ トキシシラン、γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキ シプロピルメチルジメトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、γーメルカ プトプロピルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキシシラン、γ ーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシ ラン、 γ - Γ > γ - Γ > γ - γ - アミノプロピルトリメトキシシラン、 $\gamma-$ (N,N-ジエチル)アミノプロピル トリメトキシシラン、γー(N, N-ジブチル)アミノプロピルトリメトキシシ \cdot ラン、 γ - $(N-メチル) アニリノプロピルトリメトキシシラン、<math>\gamma$ - (N-エ**チル)アニリノプロピルトリメトキシシラン、γ- (N, N-ジメチル) アミノ** プロピルトリエトキシシラン、 γ - (N, N-ジエチル) アミノプロピルトリエ



トキシシラン、γ - (N, N-ジブチル) アミノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma-(N-メチル)$ アニリノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma-(N-エチル)$ アニリノプロピルトリエトキシシラン、 $\gamma-$ (N,N-ジメチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ - (N, N-ジエチル) アミノプロピルメチルジ メトキシシラン、 γ - (N, N-ジブチル) アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ - $(N-メチル) アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、<math>\gamma$ - (Nーエチル) アニリノプロピルメチルジメトキシシラン、N- (トリメトキシシリ ルプロピル) エチレンジアミン、N- (ジメトキシメチルシリルイソプロピル) エチレンジアミン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メ チルトリエトキシシラン、γークロロプロピルトリメトキシシラン、ヘキサメチ ルジシラン、ビニルトリメトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジメト キシシラン等のシラン系カップリング剤、イソプロピルトリイソステアロイルチ タネート、イソプロピルトリス (ジオクチルパイロホスフェート) チタネート、 イソプロピルトリ(Nーアミノエチルーアミノエチル)チタネート、テトラオク チルビス (ジトリデシルホスファイト) チタネート、テトラ (2, 2-ジアリル オキシメチルー1ーブチル) ビス (ジトリデシル) ホスファイトチタネート、ビ ス(ジオクチルパイロホスフェート)オキシアセテートチタネート、ビス(ジオ クチルパイロホスフェート) エチレンチタネート、イソプロピルトリオクタノイ ルチタネート、イソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、イソプ ロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルイソステアロ イルジアクリルチタネート、イソプロピルトリ (ジオクチルホスフェート) チタ ネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、テトライソプロピルビス (ジオクチルホスファイト) チタネート等のチタネート系カップリング剤などが 挙げられ、これらの1種を単独で用いても2種類以上を組み合わせて用いてもよ 13

[0077]

これらその他のカップリング剤を用いる場合、(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤の配合量は、その性能を発揮するためにカップリング剤全量に対して30重量%以上とすることが好ましく、50重量%以上がより好ましい





[0078]

上記(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤を含むカップリング剤の全配合量は、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して0.037~4.75重量%であることが好ましく、0.088~2.3重量%であることがより好ましい。0.037質量%未満では配線板との接着性が低下する傾向があり、4.75質量%を超えると揮発分が多くなり、ボイド等充填性に関する成形不良が発生しやすくなる傾向があるとともにパッケージの成形性が低下する傾向がある。尚、上記カップリング剤の配合量は、(C)無機充填剤に対して0.05~5重量%であることが好ましく、0.1~2.5重量%がより好ましい。配合量を規定した理由は前記と同様である。

[0079]

(カップリング剤被覆率)

本発明においてカップリング剤を用いる場合、無機充填剤へのカップリング剤の被覆率は0.3~1.0とすることが好ましく、さらに好ましくは0.4~0.9、より好ましくは0.5~0.8の範囲とすることが都合がよい。カップリング剤の被覆率が1.0より大きい場合、成形時に発生する揮発分による気泡が増加して、薄肉部のボイドが発生しやすくなる傾向がある。また、カップリング剤の被覆率が0.3より小さい場合、樹脂と充填材との接着力が低下するため、成型品強度が低下する傾向がある。

[0080]

エポキシ樹脂組成物のカップリング剤被覆率Xは(xxx)式のように定義される。

[0081]

 $X (\%) = S_c / S_f (xxx)$

 S_c 及び S_f は、それぞれエポキシ樹脂組成物における全カップリング剤の総最小被覆面積と全充填材の総表面積を表し、(yyy)式、(zzz)式で定義される。

[0082]

 $S_{c}=A_{1}\times W_{1}+A_{2}\times W_{2}+\cdots+A_{n}\times M_{n}$ (nは使用カップリング剤種数) (yyy)





 $S_{f}=B_{1}\times W_{1}+B_{2}\times W_{2}+\cdots+B_{1}\times W_{1}$ (1は使用充填材種数) (zzz)

ここで、AとMはそれぞれ各カップリング剤の最小被覆面積およびその使用量、 、BとWはそれぞれ各充填材の比表面積およびその使用量を表す。

[0083]

(カップリング剤被覆率の制御方法)

エポキシ樹脂組成物に使用する各カップリング剤および無機充填剤それぞれの最小被覆面積および比表面積が既知であれば、(xxx)式、(yyy)式および(zzz)式より、目的のカップリング剤被覆率となるカップリング剤および充填材の使用量を算出することが可能である。

[0084]

(リン化合物)

充填性、難燃性の観点からは、本発明において、さらに(E)リン化合物を配合することが好ましい。本発明において用いられる(E)リン化合物としては特に制限はないが、耐湿信頼性の観点からリン酸エステル、ホスフィンオキサイドが好ましい。

[0085]

リン酸エステルはリン酸とアルコール化合物又はフェノール化合物のエステル化合物であれば特に制限はないが、例えばトリメチルホスフェート、トリエチルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、クレジルジフェニルホスフェート、キシレニルジフェニルホスフェート、トリス(2,6ージメチルフェニル)ホスフェート及び芳香族縮合リン酸エステル等が挙げられる。なかでも耐加水分解性の観点からは、下記一般式(II)で示される芳香族縮合リン酸エステルが好ましい。

[0086]



【化14】

(ここで、式中の8個のRは炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を示し、全て同一でも異なっていてもよい。Arは芳香族環を示す。)

上記式(II)のリン酸エステルを例示すると、下記構造式(XVI)~ (XX)で示されるリン酸エステル等が挙げられる。

[0087]



【化15】

これらリン酸エステルの添加量は、充填剤を除く他の全配合成分に対して、燐原子の量で 0.2~3.0質量%の範囲内であることが好ましい。0.2質量%



より少ない場合は充填性が低下し、ボイド等の成形不良が発生しやすくなる。また難燃効果が低くなる傾向がある。3.0質量%を超えた場合は成形性、耐湿性の低下や、成形時にこれらのリン酸エステルがしみ出し、外観を阻害する場合がある。

[0088]

ホスフィンオキサイドとしては下記一般式(III)で示される化合物が好ましい。

【化16】

(ここで、 R^1 、 R^2 及び R^3 は炭素数 $1\sim10$ の置換又は非置換のアルキル基、アリール基、アラルキル基及び水素原子を示し、すべて同一でも異なってもよい。ただしすべてが水素原子である場合を除く。)

上記一般式(I)で示されるリン化合物の中でも、耐加水分解性の観点からは $R^{1} \sim R^{3}$ が置換又は非置換のアリール基であることが好ましく、特に好ましくはフェニル基である。

[0090]

ホスフィンオキサイドの配合量は封止用エポキシ樹脂成形材料に対してリン原子の量が $0.01\sim0.2$ 重量%であることが必要である。好ましくは $0.02\sim0.1$ 重量%であり、さらに好ましくは $0.03\sim0.08$ 重量%である。0.01重量%未満であると難燃性が低下し、0.2重量%を超えると成形性、耐湿性が低下する。

[0091]

(硬化促進剤)

硬化性の観点からは、本発明において、さらに(F)硬化促進剤を配合するこ



とが好ましい。本発明において用いられる(F)硬化促進剤としては封止用エポ キシ樹脂成形材料に一般に使用されているものであれば特に制限はないが、たと えば、1,8-ジアザービシクロ(5,4,0)ウンデセンー7、1,5-ジア ザービシクロ(4,3,0)ノネン、5、6-ジブチルアミノー1,8-ジアザ -ビシクロ(5, 4, 0) ウンデセンー7等のシクロアミジン化合物及びこれら の化合物に無水マレイン酸、1,4-ベンゾキノン、2,5-トルキノン、1, 4ーナフトキノン、2, 3ージメチルベンゾキノン、2, 6ージメチルベンゾキ ノン、2,3-ジメトキシー5-メチルー1,4-ベンゾキノン、2,3-ジメ トキシー1, 4ーベンゾキノン、フェニルー1, 4ーベンゾキノン等のキノン化 合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂などのπ結合をもつ化合物を付加 してなる分子内分極を有する化合物、ベンジルジメチルアミン、トリエタノール アミン、ジメチルアミノエタノール、トリス (ジメチルアミノメチル) フェノー ル等の3級アミン類及びこれらの誘導体、2-メチルイミダゾール、2-フェニ ルイミダゾール、2-フェニルー4-メチルイミダゾール等のイミダゾール類及 びこれらの誘導体、トリブチルホスフィン、メチルジフェニルホスフィン、トリ フェニルホスフィン、トリス (4-メチルフェニル) ホスフィン、ジフェニルホ スフィン、フェニルホスフィン等の有機ホスフィン類及びこれらのホスフィン類 に無水マレイン酸、上記キノン化合物、ジアゾフェニルメタン、フェノール樹脂 等のπ結合をもつ化合物を付加してなる分子内分極を有するリン化合物、テトラ フェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、トリフェニルホスフィンテトラ フェニルボレート、2-エチルー4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレー ト、Nーメチルモルホリンテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩 及びこれらの誘導体などが挙げられ、これらを単独で用いても2種以上を組み合 わせて用いてもよい。なかでも充填性及び耐リフロー性の観点からは有機ホスフ ィンとキノン化合物との付加物が好ましい。

[0092]

硬化促進剤の配合量は、硬化促進効果が達成される量であれば特に制限されるものではないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して $0.05 \sim 2$ 重量%が好ましく、より好ましくは $0.01 \sim 0.5$ 重量%である。0.005 重量%未



満では短時間での硬化性に劣る傾向があり、2重量%を超えると硬化速度が速すぎて良好な成形品を得ることが困難になる傾向がある。

[0093]

(難燃剤)

本発明には難燃性の観点から、さらに各種難燃剤を添加してもよい。難燃剤は 封止用エポキシ樹脂成形材料に一般に使用されているもので特に制限はないが、 たとえば、テトラブロモビスフェノールAのジグリシジルエーテル化物やブロム 化フェノールノボラックエポキシ樹脂等のブロム化エポキシ樹脂。酸化アンチモン、赤リン及び前述のリン酸エステル等の燐化合物、メラミン、メラミンシアヌレート、メラミン変性フェノール樹脂及びグアナミン変性フェノール樹脂等の含 窒素化合物、シクロホスファゼン等の燐/窒素含有化合物、酸化亜鉛、酸化鉄、 酸化モリブデン、フェロセン、上記水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム及 び複合金属水酸化物等の金属化合物などが挙げられる。

[0094]

近年の環境問題や高温放置特性の観点からは非ハロゲン、非アンチモン系の難燃剤が好ましい。なかでも充填性の観点からはリン酸エステルが好ましく、安全性、耐湿性の観点からは複合金属水酸化物が好ましい。

[0095]

複合金属水酸化物は下記組成式(XXI)で示される化合物が好ましい。

[0096]

 $p(M^1aOb) \cdot q(M^2cOd) \cdot r(M^3cOd) \cdot mH_2O$ (XXI) (ここで、 M^1 、 M^2 及び M^3 は互いに異なる金属元素を示し、a、b、c、d、p、q及びmは正の数、rは0又は正の数を示す。)

なかでも、上記組成式(XXI)中のrが0である化合物、すなわち、下記組成式(XXIa)で示される化合物がさらに好ましい。

[0097]

 $m(M^1aOb)\cdot n(M^2cOd)\cdot l(H_2O)$ (XXI a) (ここで、 M^1 及び M^2 は互いに異なる金属元素を示し、a、b、c、d、m、n 及び l は正の数を示す。)



上記組成式(XXI)及び(XXI a)中の M^1 及び M^2 は互いに異なる金属元素であれば特に制限はないが、難燃性の観点からは、 M^1 と M^2 が同一とならないように M^1 が第 3 周期の金属元素、IIA族のアルカリ土類金属元素、IVB族、IIB族、VIII族、IB族、IIIA族及びIVA族に属する金属元素から選ばれ、 M^2 がIIIB~IIB族の遷移金属元素から選ばれることが好ましく、 M^1 がマグネシウム、カルシウム、アルミニウム、スズ、チタン、鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれ、 M^2 が鉄、コバルト、ニッケル、銅及び亜鉛から選ばれることがより好ましい。流動性の観点からは、 M^1 がマグネシウム、 M^2 が亜鉛又はニッケルであることが好ましく、 M^1 がマグネシウムで M^2 が亜鉛であることがより好ましい。

[0098]

上記組成式(XXI)中のp、q、rのモル比は本発明の効果が得られれば特に制限はないが、r=0で、p及びqのモル比p/qが99/1~50/50であることが好ましい。すなわち、上記組成式(XXIa)中のm及びnのモル比m/nが99/1~50/50であることが好ましい。

[0099]

なお、金属元素の分類は、典型元素をA亜族、遷移元素をB亜族とする長周期型の周期率表(出典:共立出版株式会社発行「化学大辞典4」1987年2月15日縮刷版第30刷)に基づいて行った。

[0100]

複合金属水酸化物の形状は特に制限はないが、流動性、充填性の観点からは、 平板状より、適度の厚みを有する多面体形状が好ましい。複合金属水酸化物は、 金属水酸化物と比較して多面体状の結晶が得られやすい。

[0101]

複合金属水酸化物の配合量は特に制限はないが、封止用エポキシ樹脂成形材料に対して $0.5\sim20$ 重量%が好ましく、 $0.7\sim15$ 重量%がより好ましく、 $1.4\sim12$ 重量%がさらに好ましい。0.5重量%未満では難燃性が不十分となる傾向があり、20重量%を超えると充填性及び耐リフロー性が低下する傾向がある。



[0102]

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料について好ましい態様をいくつか挙 げてさらに説明する。

[0103]

(第1の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第1の好ましい態様としては、必須成分として(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、及び(C)平均粒径が15 μ m以下、比表面積が3.0~6.0 m²/g である無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、所望により(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)リン化合物及び(F)硬化促進剤のいずれかをさらに加えててもよい。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによって、フリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が15 μ m以下、比表面積が3.0~6.0 m²/g である無機充填剤の選定とその配合量が特に重要である。

[0104]

(第2の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第2の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、さらに任意成分としての(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤を加えても良い。また他の添加剤を加えても良い。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによってフリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である無機充填剤及び、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤の選定と配合量が特に重要である。

[0105]

(第3の態様)



本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第3の好ましい態様としては、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m²/g である無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が 挙げられる。この場合、さらに任意成分としての(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)リン化合物のいずれかを加えてもよい。また他の添加剤を加えても良い。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによってフリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤、(C)平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m²/g である無機充填剤及び、(D)2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E)リン化合物の選定と配合量が特に重要である。

[0106]

(第4の態様)

本発明に係る封止用エポキシ樹脂成形材料の第4の好ましい態様においては、 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m2/g である無機充填剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が挙げられる。この場合、さらに任意成分としての(D) 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E) リン化合物及び(F) 硬化促進剤のいずれかを加えても良い。各成分の組み合わせ及び配合量を調整することによってフリップチップ実装型のアンダーフィル用封止用エポキシ樹脂成形材料を得ることができる。なかでも(A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m2/g である無機充填剤及び、(D) 2 級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E) リン化合物及び(F) 硬化促進剤の選定と配合量が特に重要である。

[0107]

ファインピッチのはんだバンプ等を備える次世代フリップチップ型半導体装置の製造において、従来の固形タイプの封止用エポキシ樹脂を用いて封止する場合、直径0.1mm程度のやや大きめのボイドの発生に起因してアンダーフィル部の充填は満足できるものではなかった。ところが前記第1から第4の態様に代表



される本発明の封止用エポキシ樹脂を封止材として用いることにより、前記問題は解消されるに至った。即ち、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、後に半導体装置の欄で説明する所定の構成を備える半導体装置の製造に好適に使用されるものである。

[0108]

ここで、(A)エポキシ樹脂、(B)硬化剤及び(C)無機充填剤の選定は以下の観点から行われることが好ましい。

[0109]

(A) エポキシ樹脂の選定においては150℃における溶融粘度が2ポイズ以下であるものを選択することが好ましく、1ポイズ以下であるものを選択することがより好ましい。(C) 無機充填剤の配合割合が高い場合にこの選択は特に有効である。中でもビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂から選択される少なくとも1つ以上を使用することが充填性、信頼性の観点から好ましい。またフリップチップ実装型パッケージにおける反りを低減する観点からはナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂から選択される少なくとも1つ以上を使用することが好ましい。充填性と反りを両立するためにはビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂及び硫黄原子含有エポキシ樹脂から選択される少なくとも1つ以上とナフタレン型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン型エポキシ樹脂から選択される少なくとも1つ以上を併用することが好ましい。

[0110]

(B) 硬化剤の選定においては150℃における溶融粘度は2ポイズ以下であるものを選択することが好ましく、1ポイズ以下であるものを選択することがより好ましい。(C) 無機充填剤の配合割合が高い場合にこの選択は特に有効である。また成形性の観点から(A) エポキシ樹脂としてノボラック型エポキシ樹脂から選択される少なくとも1つ以上を使用した場合、低吸湿性の観点からジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂を選択した場合、耐熱性及び低反り性の観点からナフタレン型エポキシ樹脂及びトリフェニルメタン型エポキシ樹脂から選択され





る少なくとも1つ以上を使用した場合も上記選択は特に有効である。

[0111]

(C) 平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m 2 /gである無機充填剤の選定においては、平均粒径は 15μ m以下の範囲で、適用する本発明範囲のフリップチップ実装型半導体装置におけるバンプ高さ及びバンプピッチを考慮して注入可能な大きさのものを選択することが必要であるが、必要以上に小さいものを選択することは流動性が低下し、充填性が低下する。これを避けるためには比表面積が $3.0\sim6.0$ m 2 /gの範囲を満たすものを選択することが必要である。平均粒径、比表面積両者を上記範囲で満たすためには市販の無機充填剤2 種以上を組み合せて調整することが有効である。

[0112]

さらには必要により(C)無機充填剤の粗粒子分を篩にてカットしてもよい。 53μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることが好ましく、 30μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがより好ましく、 20μ m以上の(C)成分が 0.5 重量%以下であることがさらに好ましい。

[0113]

また、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、IC等の半導体素子の耐湿性及び高温放置特性を向上させる観点から陰イオン交換体を添加することもできる。陰イオン交換体としては特に制限はなく、従来公知のものを用いることができるが、たとえば、ハイドロタルサイト類や、マグネシウム、アルミニウム、チタン、ジルコニウム、ビスマス等から選ばれる元素の含水酸化物等が挙げられ、これらを単独又は2種以上を組み合わせて用いることができる。なかでも、下記組成式(XXII)で示されるハイドロタルサイトが好ましい。

[0114]

 $Mg_{1-X}Al_X(OH)_2(CO_3)_{X/2} \cdot mH_2O \cdot \cdot \cdot (XXII)$ (0 < X ≤ 0.5、mは正の数)

さらに、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料には、その他の添加剤として、 高級脂肪酸、高級脂肪酸金属塩、エステル系ワックス、ポリオレフィン系ワック ス、ポリエチレン、酸化ポリエチレン等の離型剤、カーボンブラック等の着色剤



、シリコーンオイルやシリコーンゴム粉末等の応力緩和剤などを必要に応じて配 合することができる。

[0115]

(調製・使用方法)

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料は、各種原材料を均一に分散混合できるのであれば、いかなる手法を用いても調製できるが、一般的な手法として、所定の配合量の原材料をミキサー等によって十分混合した後、ミキシングロール、押出機、らいかい機、プラネタリミキサ等によって混合又は溶融混練した後、冷却し、必要に応じて脱泡、粉砕する方法等を挙げることができる。また、必要に応じて成形条件に合うような寸法及び重量でタブレット化してもよい。

[0116]

本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料を封止材として用いて、半導体装置を封止する方法としては、低圧トランスファ成形法が最も一般的であるが、インジェクション成形法、圧縮成形法等も挙げられる。ディスペンス方式、注型方式、印刷方式等を用いてもよい。充填性の観点からは減圧状態にて成形できる成形法が好ましい。

[0117]

(半導体装置)

続いて本発明の半導体装置について説明する。半導体装置の説明を介して本発明のエポキシ樹脂成形材料の好適な用途及び使用方法についても説明する。

[0118]

本発明の半導体装置としては、配線済みのテープキャリア、配線板、ガラス等の支持部材や実装基板に、半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子、コンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子等の素子を搭載し、封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したフリップチップ実装型の半導体装置などが挙げられる。

[0119]

ここで、前記封止用エポキシ樹脂成形材料としては、本発明の封止用エポキシ 樹脂成形材料を用いることができる。即ち必須成分として(A)エポキシ樹脂、



(B) 硬化剤、及び(C) 平均粒径が 15μ m以下、比表面積が $3.0\sim6.0$ m 2/gである無機充填剤を含有し、所望により(D) 2級アミノ基を有するシランカップリング剤、(E) リン化合物及び(F) 硬化促進剤のいずれかを含有する封止用エポキシ樹脂成形材料が用いられる。

[0120]

前記実装基板としては特に制限するものではなく、たとえば、有機基板、有機フィルム、セラミック基板、ガラス基板等のインターポーザ基板、液晶用ガラス基板、MCM (Multi Chip Module) 用基板、ハイブリットIC用基板等が挙げられる。

[0121]

本発明の半導体装置としては以下の(a1)~(e1)の構成を1以上備えるものが好ましい。尚、本発明において「封止材の総厚さ」とはアンダーフィルタイプにあってはバンプ高さをいうものとする。

- (a1) フリップチップのバンプ高さが150μm以下である
- (b1) フリップチップのバンプピッチが 500μm以下である
- (c1) 半導体チップの面積が $2.5 \, \text{mm}^2$ 以上である
- (d1) 對止材の総厚さが2mm以下である
- (e1)フリップチップのバンプ数が100以上である

以下の(a 2)~(e 1)の構成を1以上備えるものがより好ましい。

- $(a\ 2)$ フリップチップのバンプ高さが $1\ 0\ 0\ \mu$ m以下である
- (b2) フリップチップのバンプピッチが400μm以下である
- (c2) 半導体チップの面積が 50 mm^2 以上である
- (d2) 封止材の総厚さが1.5 mm以下である
- (e2) フリップチップのバンプ数が150以上である

前記(a1)~(e1)、(a2)~(e2)の構成を以下の組み合わせで備える半導体装置がさらに好ましい。

充填性の観点からは、構成(b1)及び(c1)を備える半導体装置に好適に用いられ、構成(b2)及び(c2)を備える半導体装置により好適に用いられ、構成(b3)及び(c3)を備える半導体装置にさらに好適に用いられる。



[0122]

バリ性の観点からは、構成(c1)とその他の構成を1以上備える半導体装置に 好適に用いられ、構成(c2)とその他の構成を1以上備える半導体装置により好 適に用いられ、構成(c3)とその他の構成を1以上備える半導体装置にさらに好 適に用いられる。

[0123]

このような半導体装置としては、たとえば、配線板やガラス上に形成した配線に、フリップチップボンディングで接続した半導体チップを、本発明の封止用工ポキシ樹脂成形材料で封止したCOB(Chip On Board)、COG(Chip On Glass)等のベアチップ実装した半導体装置、配線板やガラス上に形成した配線に、フリップチップボンディングで接続した半導体チップ、トランジスタ、ダイオード、サイリスタ等の能動素子及び/又はコンデンサ、抵抗体、コイル等の受動素子を、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で封止したハイブリッドIC、MCM(Multi Chip Module)マザーボード接続用の端子を形成したインターポーザ基板に半導体チップを搭載し、バンプにより半導体チップとインターポーザ基板に形成された配線を接続した後、本発明の封止用エポキシ樹脂成形材料で半導体チップ搭載側を封止したBGA(Ball Grid Array)、CSP(Chip Size Package)、MCP(Multi Chip Package)などが挙げられる。また、これらの半導体装置は、実装基板上に素子が2個以上重なった形で搭載されたスタックド(積層)型パッケージであっても、2個以上の素子を一度に封止用エポキシ樹脂成形材料で封止した一括モールド型パッケージであってもよい。

[0124]

本発明の半導体装置の好ましい態様を図1~図3を参照しながら説明する。

[0125]

尚、本発明の半導体装置はこれらに限られるものではない。

[0126]

図1には、アンダーフィルタイプのフリップチップ型BGAの断面図が示されており、図2には、オーバーモールドタイプのフリップチップ型BGAの断面図が示されている。また図3にはフリップチップ型BGAの配線板1上にはんだバ



ンプ2を介して半導体チップ3を配置した際の上面図 (一部透視図) が示されている。

[0127]

図1に示されるアンダーフィルタイプのフリップチップ型BGAの半導体装置10は、図3に示されるように配線板1上にはんだバンプ2を所定のバンプピッチbで配置し;そのはんだバンプ2を介してバンプ高さaで半導体チップ3を配線板1上に接続・固定し;そして配線板1と半導体チップ3間に形成されるアンダーフィル部5を封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)4を用いて封止することにより得られるものである。図2に示されるオーバーモールドタイプのフリップチップ型BGAの半導体装置20は、前記封止工程においてアンダーフィル部5を封止すると共に半導体チップ3全体を覆うように封止することを除いて、前記と同様にして製造されるものである。

[0128]

ここで、本発明の半導体装置の製造に際しては、半導体装置のバンプ高さa、バンプピッチb、半導体チップの面積 c 及び封止材の総厚さdを以下のように設定することが好ましい。

[0129]

はんだバンプ 2 の高さ a は 150μ m以下であることが好ましく、 100μ m 以下であることがより好ましく、 80μ m以下であることがさらに好ましい。

[0130]

はんだバンプ 2 のピッチ b すなわちはんだバンプの中心間隔は 5 0 0 μ m以下であることが好ましく、 4 0 0 μ m以下であることがより好ましく、 3 0 0 μ m以下であることがさらに好ましい。

[0131]

半導体チップ3の面積 c は $2.5 \, \text{mm}^2$ 以上であることが好ましく、 $5.0 \, \text{mm}^2$ 以上であることがより好ましく、 $8.0 \, \text{mm}^2$ 以上でることがさらに好ましい。

[0132]

封止材4の総厚さdは2mm以下であることが好ましく、1.5mm以下であることがより好ましく、1.0mm以下であることがさらに好ましい。



[0133]

尚、アンダーフィルタイプにあっては総厚さとバンプ高さaは同一の値となる。

[0134]

【実施例】

次に実施例により本発明を説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例に限定されるものではない。なお、各封止用エポキシ樹脂成形材料及び半導体装置の評価は特記しない限り後に説明する評価方法に基づいて行った。

[0135]

〔封止用エポキシ樹脂成形材料の作製〕

以下に挙げる成分をそれぞれ表1に示す重量部で配合し、混練温度80℃、混 練時間10分の条件でロール混練を行い、実施例1から4及び比較例1から4に かかる封止用エポキシ樹脂成形材料を作製した。

[0136]

(エポキシ樹脂)

エポキシ樹脂D:エポキシ当量186、融点75℃のビスフェノールF型エポキシ樹脂(新日鉄化学株式会社製商品名YSLV-80XY)

(硬化剤)

フェノール樹脂A:水酸基当量103、150℃の溶融粘度1.3poiseの トリフェノールメタン型フェノール樹脂(明和化成製商品名MEH-7500-3S)

フェノール樹脂B:軟化点80℃、水酸基当量106のフェノールノボラック樹脂(明和化成株式会社製商品名H-1)



(硬化促進剤)

硬化促進剤A:トリフェニルホスフィンとp-ベンゾキノンの付加物

硬化促進剤B:トリス(4ーメチルフェニル)ホスフィンとp-ベンゾキノンの

付加物

(離型剤)

離型剤A:ポリエチレンワックス (クラリアント社製)

離型剤B:モンタン酸エステル(クラリアント社製)

(難燃剤)

難燃剤:エポキシ当量375、軟化点80℃、臭素含量48重量%のビスフェノールA型ブロム化エポキシ樹脂(住友化学工業株式会社製商品名ESB-400T)

難燃助剤:三酸化アンチモン

(着色剤)

カーボンブラック:カーボンブラック (三菱化学株式会社製商品名MA-100)

(その他添加剤)

添加剤A:ポリエーテル変性シリコーンオイル(東レ・ダウコーニング・シリコーン社製)、添加剤B:エポキシ変性シリコーンオイル(東レ・ダウコーニング・シリコーン社製)、添加剤C:ハイドロタルサイト、添加剤D:水酸化ビスマス

(カップリング剤)

カップリング剤 $A: \gamma$ -アニリノプロピルトリメトキシシラン(アニリノシラン)、カップリング剤B:メチルトリメトキシシラン、カップリング剤 $C: \gamma-$ メルカプトプロピルトリメトキシシラン、カップリング剤 $D: \gamma-$ グリシドキシプロピルトリメトキシシラン(エポキシシラン)

(無機充填剤)

溶融シリカ:全て球状溶融シリカ



【表1】

	実施例				比較例			
	1	2	3	4	1	2	3	4
工术°キシ樹脂 A	6.06				5.96	5.06		† — —
エポキシ樹脂 B		6.84	6.97					6.26
エポキシ樹脂 C				5.41		 	6.74	
邛°キシ樹脂 D				2.25		 	0.90	
フェノール樹脂	3.60	4.42	4.51	4.87	3.54	3.54	4.95	4.07
硬化促進剤	0.32	0.24	0.25	0.18	0.32	0.16	0.16	0.18
離型剤	0.32	0.14	0.33	0.15	0.32	0.06	0.15	0.12
難燃剤	1.07	1.21	1.23	1.35	1.05	0.56	1.35	1.10
難燃助剤	1.07	1.21	1.23	1.35	1.05	0.34	1.35	1.10
カーホーンフ・ラック	0.36	0.24	0.25	0.27	0.35	0.15	0.27	0.22
添加剤	1.72	1.93	1.97	1.71	1.68	0.06	2.16	1.76
カッフ°リンク*剤 A *1	0.31	0.35	0.17	0.19	0.47		0.39	0.32
カッフ°リンク゛斉I B *2	0.21	0.24	0.12	0.14	0.32	0.25	0.27	0.22
カッフ°リンク*剤 C *3	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
カッフ°リンク*斉J D *4						0.37		0.01
溶融シリカ A *5	76.46				76.48	80.46		
溶融シリカ B *6		66.52	66.50	65.35				
溶融シリカ C *7							56.92	
溶融シリカ D *8								76.00
溶融シリカ E *9	8.49				8.47	8.93		8.47
溶融シリカ F *10		16.65	16.65	16.31			24.37	5.41
平均粒径(µm)	13.5	8.46	8.46	8.46	13.5	13.5	4.3	15.3
比表面積(m ¹ /g)	3.43	4.62	4.62	4.62	3.43	3.43	3.04	3.40
カップリング剤被覆率	0.77	0.65	0.34	0.375	1.13	0.86	1.14	0.79
(%)							, , , ,	0.73
加熱減量率(質量%)	0.185	0.223	0.142	0.142	0.279	0.254	0.216	0.191
ボイド面積(mm²)	0.103	0.124	0.115	0.110	0.181	0.146	0.149	0.175

式中の略語は以下の意味を有する。

[0137]

*1:最小被覆面積307.0m²/g、*2:最小被覆面積575.6 m²/g 、*3:最小被覆面積399.4m²/g、



*4:最小被覆面積315.2m²/g、

*5:平均粒径 $11.7\,\mu$ m、比表面積 $3.2\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、*6:平均粒径 $10.8\,\mu$ m、比表面積 $4.2\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、

*7:平均粒径9.3 μ m、比表面積1.6 m^2/g 、*8:平均粒径13.5 μ m、比表面積3.2 m^2/g 、

*9:平均粒径 $0.6\,\mu$ m、比表面積 $5.5\text{m}^2/\text{g}$ 、*10:平均粒径 $0.5\,\mu$ m、比表面積 $6.3\text{m}^2/\text{g}$

[0138]

(1) ボイド面積評価方法

縦9. $1\,\mathrm{mm} \times$ 横8. $2\,\mathrm{mm} \times$ 厚さ0. $4\,\mathrm{mm}$ (面積 $7\,4$. $6\,\mathrm{mm}^{\,2}$)、バンプ径 $2\,0\,0\,\mu$ m、バンプ深さ $1\,3\,5\,\mu$ m、バンプピッチ $4\,9\,0\,\mu$ mの半導体素子をキャビティ中央となる位置に固定し、金型温度 $1\,6\,5\,\mathrm{C}$ 、成形圧力 4. $4\,\mathrm{MP}$ a、真空度 0. $1\,\mathrm{MP}$ a、キャビティ内充填時間 7. $5\,\mathrm{秒}$ 、硬化時間 $9\,0\,\mathrm{ਐの成形}$ 条件において、封止用エポキシ樹脂成形材料による真空トランスファ成形を行い、縦 $1\,4\,\mathrm{mm} \times$ 横 $2\,2\,\mathrm{mm} \times$ 厚さ 0. $7\,\mathrm{mm}$ の成形品を作成する。

得られた成形品のバンプ部に発生したボイドを倍率Xで写真撮影し、写真上のボイド 面積SPと写真倍率から、(xx)式より実際のボイド面積SBを算出する。 SB=SP/X (xx)

[0139]

【発明の効果】

本発明になるフリップチップ実装用の封止用エポキシ樹脂成形材料はアンダーフィル材として要求される高い充填性を有し、ボイド等の成形不良が少なく、また耐リフロー性、耐湿性等の信頼性にも優れるため、その工業的価値は大である

【図面の簡単な説明】

図1

図1には、封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)を用いて封止したフリップ チップ型BGA(アンダーフィルタイプ)の断面図が示されている。

【図2】



図2には、封止用エポキシ樹脂成形材料(封止材)を用いて封止したフリップ チップ型BGA(オーバーモールドタイプ)の断面図が示されている。

【図3】

図3には、配線板1上にはんだバンプ2を介して半導体チップ3を配置した際の上面図 (一部透視図) が示されている。

【符号の説明】

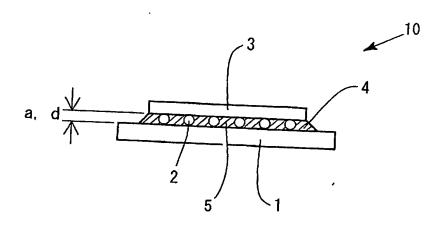
- 1:配線板
- 2:はんだバンプ
- 3:半導体チップ
- 4:封止材
- 5:アンダーフィル部
- a:バンプ高さ
- b:バンプピッチ
- c:半導体チップの面積
- d:封止材の総厚さ



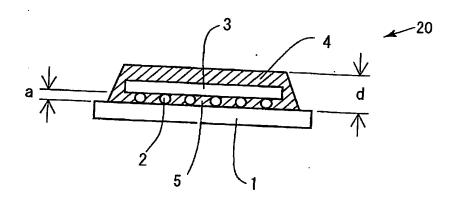
【書類名】

図面

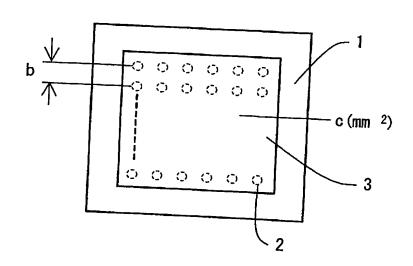
【図1】



【図2】



【図3】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 フリップチップ実装用のアンダーフィル材として好適な充填性に優れる封止用エポキシ樹脂成形材料及びこれにより封止されたボイド等の成形不良や耐リフロー性、耐湿性等の信頼性が良好なフリップチップ実装型の半導体装置を提供する。

【解決手段】 (A) エポキシ樹脂、(B) 硬化剤、(C) 無機充填剤、(D) カップリング剤を含有する封止用エポキシ樹脂成形材料であって、

前記(C)無機充填剤の比表面積は3.0 \sim 6.0 m^2/g である封止用エポキシ樹脂成形材料。

【選択図】 なし



特願2003-103438

出願人履歴情報

識別番号

[000004455]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名

1993年 7月27日 住所変更 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 日立化成工業株式会社